

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1 — вход <i>МО1</i>	9 — выход счетчика <i>Q1</i>
2 — вход «сброс» <i>SR</i>	10 — выход счетчика <i>END</i>
3 — вход «пуск» <i>ST</i>	11 — вход управляющий <i>IN</i>
4 — вход генератора <i>RC</i>	12 — вход <i>МО2</i>
5 — выход генератора <i>C</i>	13 — вход <i>МО3</i>
6 — выход генератора <i>R</i>	14 — вход <i>МО4</i>
7 — свободный	15 — вход <i>МО5</i>
8 — общий	16 — +5 В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$5 \pm 20\%$
Ток потребления, мкА, не более	20
Ток потребления в динамическом режиме, мА, не более	1
Выходное напряжение, В:	
низкого уровня, не более:	
для выводов 5, 6	0,4
» вывода 9	0,5
высокого уровня, для выводов 5, 6, не менее	3,6
Ток утечки, мкА, не более:	
низкого уровня на входе	$ -0,1 $
высокого уровня на входе:	
для вывода 4	0,1
» выводов 1—3, 11—15	50

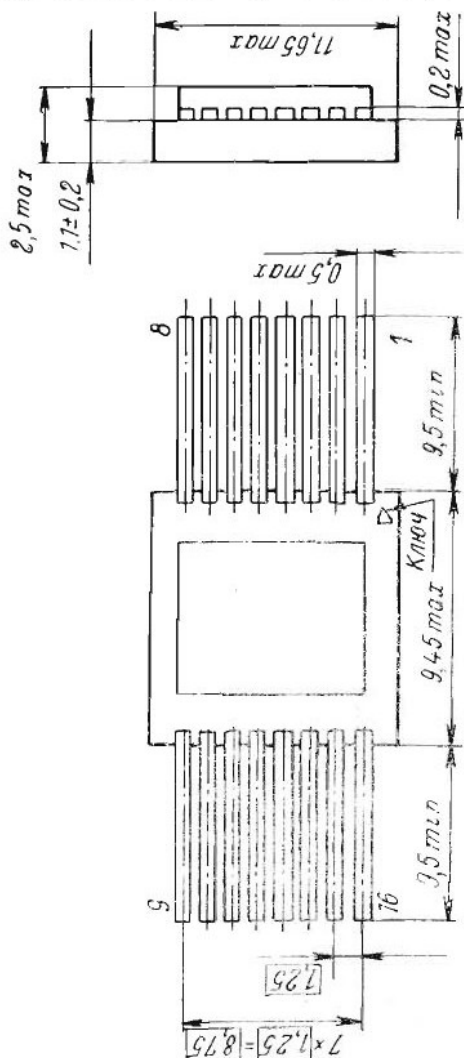
Предельно допустимые значения параметров
в режимах эксплуатации

Максимальное напряжение питания, В	6
Максимальная частота, кГц	200
Максимальная длительность фронта и среза импульса, мкс	10

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 512

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ 512ПС8, 512ПС10
(корпус 402.16-23)



Масса не более 1,5 г

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц от 1 до 5000

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц от 1 до 5000

амплитуда ускорения, $m \cdot c^{-2}$ (g) 400 (40)

Механический удар:

одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $m \cdot c^{-2}$ (g) 10 000 (1000)

длительность действия ударного ускорения, мс от 0,1 до 2

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 512

Общие данные

многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	150
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.)	
для микросхемы 512ПС10	$1,3 \cdot 10^{-4}$ (10^{-6})
» остальных микросхем	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм	
.	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхемы 512ПС10	100
» остальных микросхем	85
Пониженная температура среды, °С	
.	минус 60
Изменения температуры среды, °С:	
для микросхемы 512ПС10	от минус 60 до +100
» остальных микросхем	от минус 60 до +85
Повышенная относительная влажность при 35°С, %	
.	98
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч	50 000
Срок сохраняемости*, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11.073.041—82, ОСТ 11 073.040—82 и требованиями, изложенными ниже.

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхемы в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Установка микросхем на платы при монтаже осуществляется вплотную или с зазором не более 0,7 мм с последующей прилакировкой или приклейкой.

Допускается установка микросхем с использованием прокладки, заполняющей зазор.

При всех режимах монтажа на платах температура на корпусе микросхемы не должна превышать предельно допустимую температуру.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.